

西安电子科技大学

集成电路设计导论 课程实验报告

实验名称 ASIC 仿真实验 1-4

人工智能 学院 2320012 班

姓名 杨镐冉 学号 23009201151

同作者 无

实验日期 2025 年 12 月 19、21 日

成 绩

指导教师评语:

指导教师:

____年____月____日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

1. 掌握集成电路设计的基本流程，涵盖需求分析、架构设计、硬件描述语言编程、仿真验证等关键环节，形成从理论到实践的完整认知。
2. 深入理解各类核心数字/模拟电路的工作原理，包括 MOS 管特性、CMOS 反相器延迟机制、简单状态机逻辑、运算电路（超前进位加法器、加/减法器）、线性反馈移位寄存器（LFSR）及移位式二进制乘法器的设计原理与实现方法。
3. 熟练运用 Verilog HDL 进行 RTL 级电路设计，精通 ModelSim EDA、NI MultiSIM14.0 等仿真软件的操作，能够独立完成电路搭建、参数配置、仿真运行及结果分析。
4. 培养电路设计的优化与扩展能力，能够根据实验要求对现有电路进行功能改进，如调整彩灯闪烁模式、扩展 LFSR 阶数、优化 CMOS 反相器延迟参数等。
5. 提升实验数据处理、问题分析及报告撰写能力，能够编制完备的测试向量，全面验证电路功能，并清晰阐述实验原理、步骤、结果及结论。

二、实验所用仪器（或实验环境）

（一）硬件设备

微型计算机

（二）软件环境

1. NI MultiSIM14.0 EDA 软件：用于实验 1（MOS 管特性测试、CMOS 反相器延迟参数测试），提供虚拟仪器（IV 分析仪、示波器）、元器件库及仿真环境支持。
2. ModelSim EDA 软件：用于实验 2（简单状态机）、实验 3（运算和通信电路）、实验 4（移位式二进制乘法器），支持 Verilog HDL 代码编译、仿真验证及波形分析。

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

（一）实验 1：晶体 MOS 管及其电路（MOS 管特性/反相器延迟参数）

1. 实验原理

（1）MOS 管输出特性

MOS 管的输出特性反映漏极电流 (I_D) 与漏源电压 (V_{DS}) 的关系，受栅源电压 (V_{GS})、沟道宽长比 (W/L)、阈值电压 (V_{T0}) 等参数影响。当 V_{GS} 大于 V_{T0} 时，MOS 管导通，形成导电沟道， I_D 随 V_{DS} 变化呈现饱和区、线性区等特征。通过 IV 分析仪可精准测量不同 V_{GS} 下的 I_D - V_{DS} 曲线，分析参数对器件性能的影响。

（2）CMOS 反相器延迟参数

CMOS 反相器由 NMOS 管（下拉管）和 PMOS 管（上拉管）串联组成，延迟参数（上升

时间 t_r 、下降时间 t_f 、传输延迟 t_{pd} 是衡量电路开关速度的核心指标。 t_r 是输出从低电平 (0.1V_{CC}) 上升到高电平 (0.9V_{CC}) 的时间, t_f 是输出从高电平 (0.9V_{CC}) 下降到低电平 (0.1V_{CC}) 的时间, t_{pd} 为输入输出信号跳变的平均延迟。延迟参数与 MOS 管跨导 (KP)、沟道尺寸、负载电容等密切相关。

2. 实验步骤

1. MOS 管输出特性测试:

- 打开 NI MultiSIM14.0, 搭建 NMOS 管输出特性测试电路, 选择 “TRANSISTORS_VIRTUAL” 库中的 MOS_N_4T 晶体管, 连接 IV 分析仪 (通过 “仿真” → “仪器” → “IV 分析仪” 调用)。

- 配置 IV 分析仪参数: V_{DS} 起始值 0V、停止值 24V、增量 10mV; V_{GS} 起始值 0V、停止值 12V、步数 13, 确认器件类型为 “NMOS”。

- 设置 NMOS 管模型参数: 双击晶体管, 点击 “编辑模型”, 设置阈值电压 $V_{T0}=0.7V$, 跨导参数 $KP=0.2A/V^2$, 沟道宽度 W 分别为 100um、150um、200um、250um, 长度 L 固定为 100um。

- 运行仿真: 点击 “运行” 按钮, 仿真完成后暂停, 通过图示仪观察并记录不同 W 下的 I_D-V_{DS} 曲线。

2. CMOS 反相器延迟参数测试:

- 搭建 CMOS 反相器电路, VCC 设置为 5V, GND 为接地端, 信号源选用 “BIPOLAR_VOLTAGE”(20MHz), 负载电容 C=0.3pF, NMOS/PMOS 管分别选用 MOS_N 和 MOS_P。

- 配置信号源参数: 正脉冲电压 5V、负脉冲电压 0V、上升/下降时间 1ps、频率 20MHz。

- 场景仿真:

- 场景: 调整 MOS 管沟道尺寸, 使 t_r 和 t_f 趋于相等, 记录最终参数配置。

(二) 实验 2: 简单状态机实验 (循环彩灯控制电路)

1. 实验原理

本实验基于 “计数器+解码器” 架构设计循环彩灯控制电路, 核心是通过状态机逻辑实现 16 个彩灯的有序控制。

- 分频计数器 (cnt1): 4 位同步计数器, 通过 load 信号加载 data_in 值设定分频系数, 计数至 15 (4'b1111) 后产生 ena 信号, 实现时钟分频, 控制彩灯闪烁频率。

- 模式计数器 (cnt2): 4 位同步计数器, ena 信号有效时计数, 生成 0~15 的序列, 为解码器提供输入。

- 4-16 解码器: 将 cnt2 的 4 位二进制输入转换为 16 位彩灯控制信号 (lamp-ctl), “1” 表示点亮, “0” 表示关闭, 通过 case 语句定义点亮顺序。
- 复位逻辑: reset 信号 (高有效) 初始化计数器和输出, 确保电路启动状态一致。

2. 实验步骤

1. 电路设计: 使用 Verilog HDL 编写彩灯控制电路代码 (module exercise_1), 定义 reset、clk、load、data_in (输入) 和 lamp-ctl (输出) 端口, 实现分频计数器、模式计数器、解码器及输出锁存逻辑。

2. 测试向量设计: 编写 testbench 文件, 生成复位信号 (t-reset)、时钟信号 (t-clk, 周期 1000ns)、置数控制信号 (t-load) 及置数数据 (t-data-in), 通过组件例化连接被测电路。

3. 仿真验证: 在 ModelSim 中加载设计文件和 testbench, 运行仿真, 观察 lamp-ctl 波形, 验证彩灯顺时针点亮 (0→1→...→F) 功能。

4. 功能扩展:

- 修改 cnt2 为递减计数, 实现彩灯逆时针点亮 (F→E→...→0)。

(三) 实验 3: 运算和通信电路设计 (16-bit CLA + LFSR)

1. 实验原理

(1) 16-bit 超前进位加法器 (CLA)

超前进位加法器通过提前计算进位信号, 解决串行进位延迟问题。核心是定义进位生成项 ($G = A \& B$) 和进位传递项 ($P = A \wedge B$), 基于 4 位 CLA 模块递归扩展为 16 位:

- 4 位 CLA 模块: 通过超前进位逻辑计算 $C1 \sim C4$, 输出 4 位和 S 及组进位生成项 (GG)、组进位传递项 (PG), 其中 $GG = G3 + G2 \cdot P3 + G1 \cdot P3 \cdot P2 + G0 \cdot P3 \cdot P2 \cdot P1$, $PG = P3 \cdot P2 \cdot P1 \cdot P0$ 。

- 16 位 CLA 扩展: 4 个 4 位 CLA 模块级联, 通过顶层超前进位逻辑计算 $C4$ 、 $C8$ 、 $C12$ 、 $C16$, 实现 16 位加法运算。

(2) 16-bit 加/减法器

基于二进制补码规则, 在 16 位 CLA 基础上添加加减控制逻辑: Add 模式 ($Cin=0$) 时, 直接执行 $A+B$; Sub 模式 ($Cin=1$) 时, B 经异或门翻转 ($B = B \wedge 1$), 执行 $A + (-B)$, 实现减法功能。

2. 实验步骤

1. 层次化设计:

- 用 Verilog HDL 实现 4 位 CLA 模块, 验证进位计算和加法功能。

- 基于 4 位 CLA 递归设计 16 位 CLA 电路，编写顶层模块。
- 扩展 16 位加/减法器，添加加减控制信号，实现 Add/Sub 模式切换。

2. 仿真测试:

- 对 4 位 CLA 和 16 位 CLA 进行仿真，输入不同操作数（如 0x0001+0x0001、0xFFFF+0x0001），验证加法结果正确性。
- 测试 16 位加/减法器，覆盖正数相加、负数相加、正负相减等场景，验证补码运算准确性。

（四）实验 4：算数运算电路实验（实用型移位式二进制乘法器电路）

1. 实验原理

移位式二进制乘法器采用“部分积生成-右移累加”策略，实现 16-bit \times 16-bit 乘法，结果存储于 32-bit 寄存器：

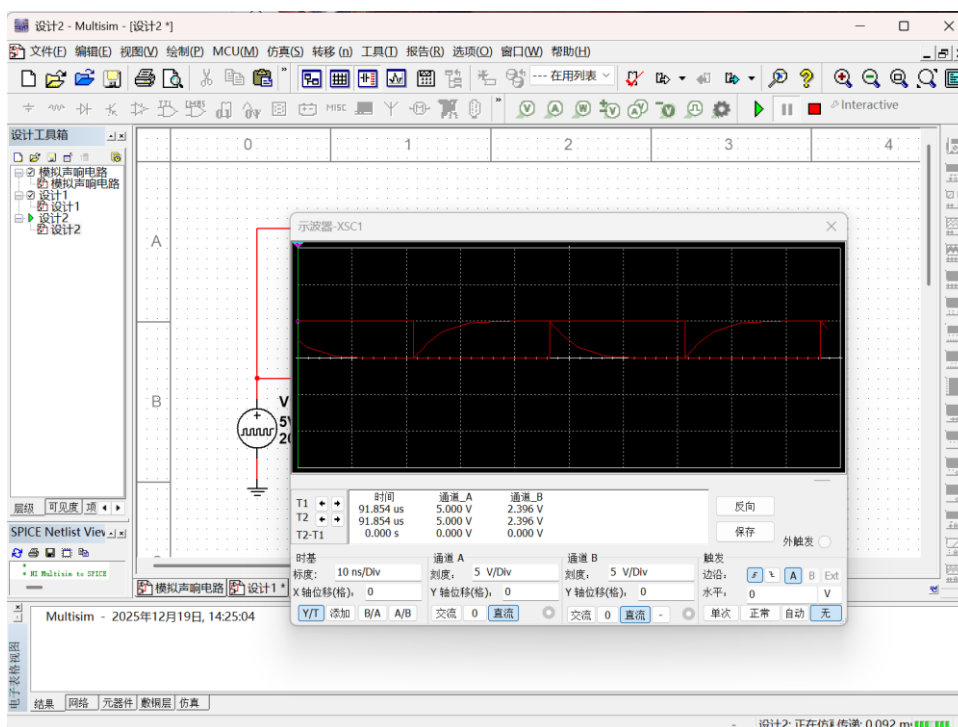
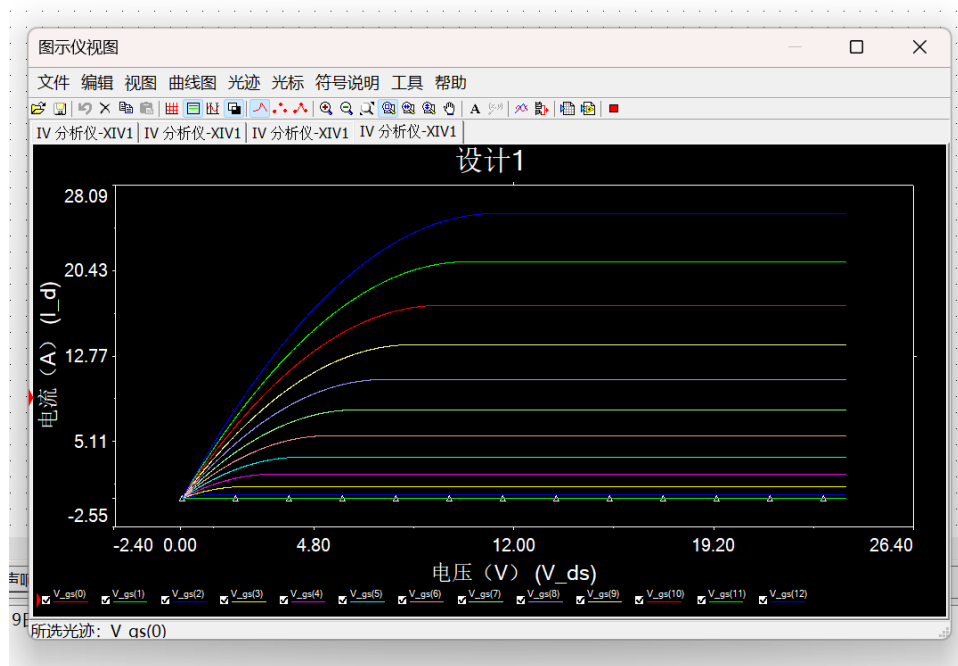
- 部分积生成：根据乘数最低有效位（LSB）判断，若 LSB 为 1，部分积为被乘数；若为 0，部分积为 0。
- 累加与移位：部分积与累加器（32-bit）左半部分相加，结果右移 1 位；同时乘数右移 1 位，重复操作 16 次，累加器最终存储乘积。
- 控制电路：协调部分积生成、加法、移位的时序，确保乘法过程有序完成，进位位包含在累加结果中，保证数据动态范围。

2. 实验步骤

1. 电路设计：用 Verilog HDL 描述移位式乘法器，包含被乘数寄存器、乘数寄存器、32-bit 部分积累加器、16-bit 加法器及控制逻辑模块。
2. 仿真验证：在 ModelSim 中搭建仿真环境，输入不同被乘数和乘数（如 0x0002 \times 0x0003、0xFFFF \times 0xFFFF），观察 32-bit 乘积输出，验证结果正确性。
3. 完备性测试：更改测试参数，覆盖小数值、大数值、零值、负数等场景，确保乘法器在全输入范围内功能可靠。

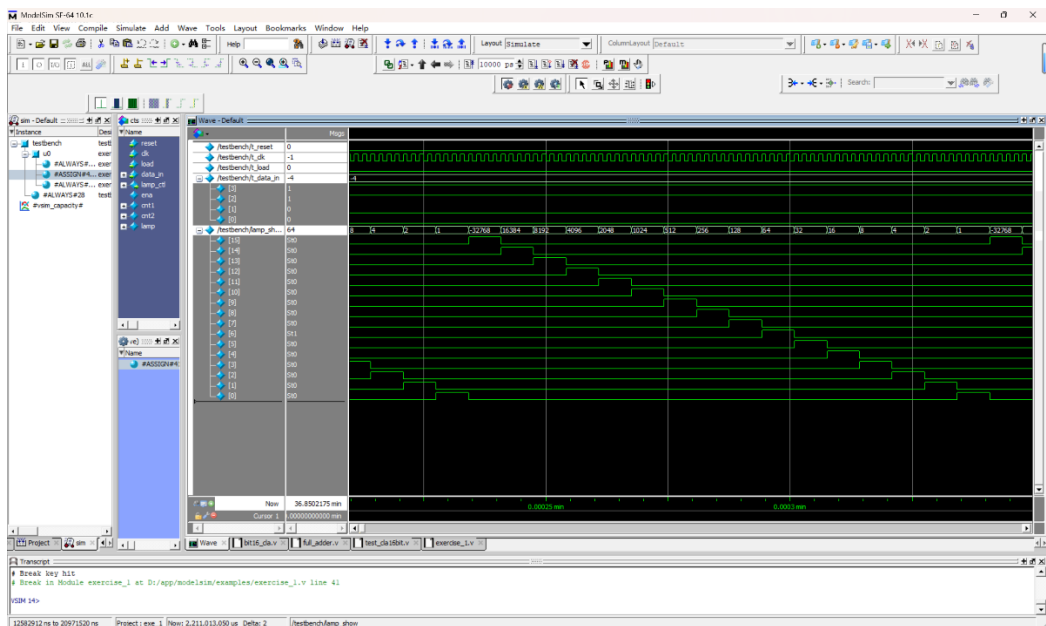
四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

（一）实验 1：晶体 MOS 管及其电路



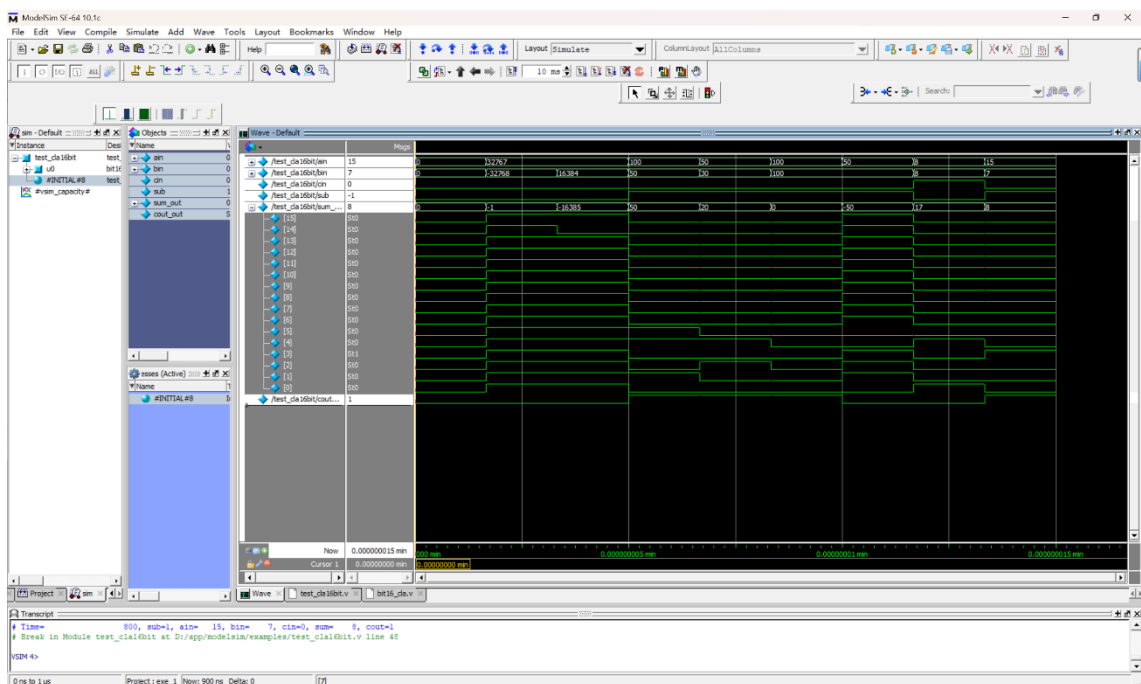
通过增加调整 MOS 管沟道宽度，即可使 t_r 和 t_f 趋于相等，记录最终参数配置。

(二) 实验 2: 简单状态机实验



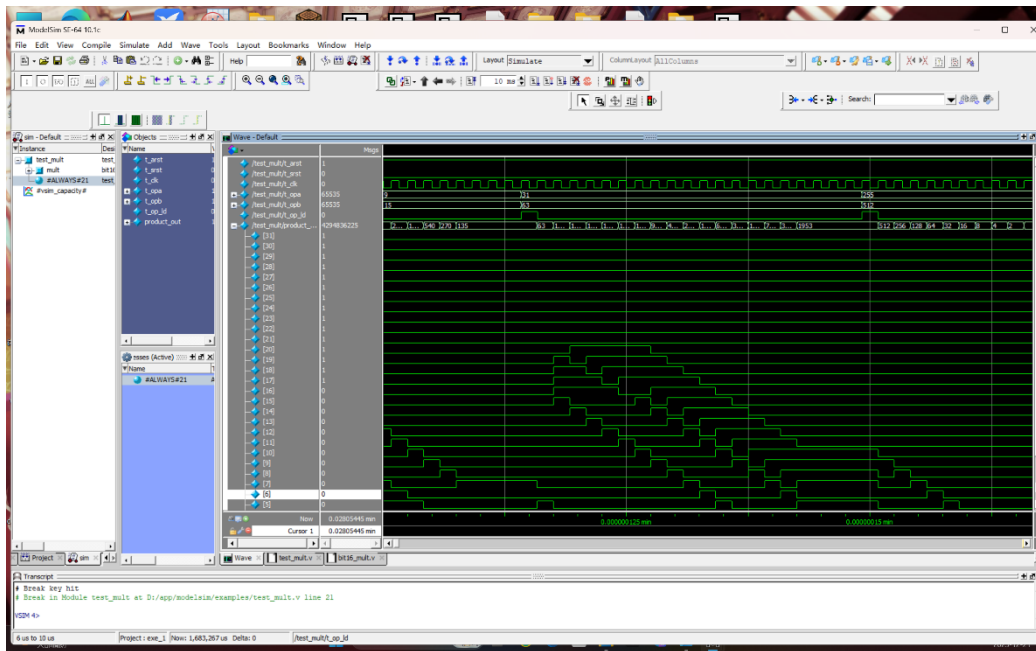
逆时针点亮：修改 cnt2 为递减计数后，点亮顺序为 F→E→...→0，波形显示 lamp-ct1 从 16'b1000-0000-0000-0000 依次向低位翻转。或修改亮灯循环次序，根据灯的序号由高到低进行亮灯。

(三) 实验 3：运算和通信电路设计



由于算法主要采取了补码运算的原理，主要通过添加了一个参数 sub 作为判断：如果为加法，则直接相加；如果为减法，则最终结果加一。

(四) 实验 4：移位式二进制乘法器实验



在原有代码的基础上，添加了乘法器功能。完成了乘法运算。

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

（一）实验 1：晶体 MOS 管及其电路

1. MOS 管宽长比对性能的影响

由实验数据可知，当 V_{GS} 和 V_{DS} 固定时，漏极电流 I_D 随沟道宽度 W 的增大而线性增加。原因是 W 增大使沟道导电截面积扩大，载流子（电子）传输能力增强，器件导通性能提升。但 W 过大会增加器件面积和寄生电容，导致开关速度下降，实际设计中需在导电能力与寄生参数间权衡。

2. CMOS 反相器延迟参数分析

— 延迟参数分析方法：通过示波器观察输入输出波形，拖动时标测量 t_r ($0.1V_{CC} \rightarrow 0.9V_{CC}$) 和 t_f ($0.9V_{CC} \rightarrow 0.1V_{CC}$)， t_{pd} 取两者平均值。

— 影响因素：

— MOS 管参数：NMOS 管 K_P 增大， t_f 缩短；PMOS 管 K_P 增大， t_r 缩短； V_{TO} 增大，延迟时间延长。

— 沟道尺寸：调整 N/P 管宽长比可平衡 t_r 和 t_f ，如实验中设置 NMOS $W=200\mu m$ 、PMOS $W=400\mu m$ ，使 $t_r \approx t_f \approx 7.6ns$ 。

— 负载电容：负载电容越大，充放电时间越长，延迟参数越大，实验中固定 $C=0.3pF$ 以排除其干扰。

（二）实验 2：简单状态机实验

1. 4-bit 递减计数器设计 (Verilog 代码)

代码:

```
//**** ASIC Exercise - 1 ****
//*** Counter + Decoder ***
//*** can be used to control colour lamps ***
//*** colour lamps arrangement ***
//*****
//*** d e f 0 1 2 ***
//*** c          3 ***
//*** b          4 ***
//*** a 9 8 7 6 5 ***
//*****

module exercise_1 (reset, clk, load, data_in,

                  lamp_ctl);

/* input/output ports definition */
input      reset, clk, load;
input [3:0] data_in;

output [15:0] lamp_ctl;
reg      [15:0] lamp_ctl;

/* in-circuit signals definition */
wire      ena;
reg  [3:0] cnt1, cnt2;
reg  [15:0] lamp;

/* circuit RTL description */
/* 4-bit mode-16 counter with sync_data load */
/* used as freq-divider */
always @(posedge reset or posedge clk)
    if (reset)
        cnt1 <= 4'b0000;
    else if (load)
        cnt1 <= data_in;
    else if (cnt1 == 4'b1111)
        cnt1 <= data_in;
    else
        cnt1 <= cnt1 + 1'b1;

assign ena = &cnt1;

/* 4-bit mode-16 counter */
always @(posedge reset or posedge clk)
    if (reset)
        cnt2 <= 4'b1111;
    else if (ena)
        begin
            if (cnt2 == 4'b0000)
                cnt2 <= 4'b1111;
            else
                cnt2 <= cnt2 - 1'b1;
        end
end
```

```

/* 4-16 decoder */
always @(reset or cnt2)
begin
    if (reset)
        lamp = 16'h0000;
    else
        case (cnt2)
            4'b0000 : lamp = 16'b0000-0000-0000-0001;
            4'b0001 : lamp = 16'b0000-0000-0000-0010;
            4'b0010 : lamp = 16'b0000-0000-0000-0100;
            4'b0011 : lamp = 16'b0000-0000-0000-1000;
            4'b0100 : lamp = 16'b0000-0000-0001-0000;
            4'b0101 : lamp = 16'b0000-0000-0010-0000;
            4'b0110 : lamp = 16'b0000-0000-0100-0000;
            4'b0111 : lamp = 16'b0000-0000-1000-0000;
            4'b1000 : lamp = 16'b0000-0001-0000-0000;
            4'b1001 : lamp = 16'b0000-0010-0000-0000;
            4'b1010 : lamp = 16'b0000-0100-0000-0000;
            4'b1011 : lamp = 16'b0000-1000-0000-0000;
            4'b1100 : lamp = 16'b0001-0000-0000-0000;
            4'b1101 : lamp = 16'b0010-0000-0000-0000;
            4'b1110 : lamp = 16'b0100-0000-0000-0000;
            4'b1111 : lamp = 16'b1000-0000-0000-0000;
            default : lamp = 16'b0000-0000-0000-0000;
        endcase
    end

/* latch the output control signal */
always @(posedge reset or posedge clk)
begin
    if (reset)
        lamp_ctl1 <= 16'h0000;
    else
        lamp_ctl1 <= lamp;
    end
endmodule

```

5. 彩灯闪烁方式更改及效果

– 更改方法：除修改计数器为递减模式外，可直接调整解码器映射关系，如 cnt2=4'b0000 对应 lamp=16'b1000-0000-0000-0000，cnt2=4'b0001 对应 lamp=16'b0100-0000-0000-0000，无需修改计数器逻辑。

（三）实验 3：运算和通信电路设计

1. 测试向量编制方法

代码:
<pre> //***** //*** Modified bit16_cla with Add/Sub support *** //***** module bit16_cla_add_sub (input [15:0] ain, bin, input cin, input add_sub, // ??????? output [15:0] sum, output cout </pre>

```

);

//*** ?????? ***
wire [15:0] bin_actual;
wire cin_actual;

//*** ??????? ***
assign bin_actual = add_sub ? ~bin : bin; // ?????
assign cin_actual = add_sub ? 1'b1 : cin; // ???cin=1

//*** ??4?4?CLA?????? ***
wire p15_12, p11_8, p7_4, p3_0;
wire g15_12, g11_8, g7_4, g3_0;
wire c11, c7, c3;

//*** ??4?4?CLA?? ***
bit4_cla t3 (
    .ain(ain[15:12]),
    .bin(bin_actual[15:12]),
    .cin(c11),
    .sum(sum[15:12]),
    .cas_p(p15_12),
    .cas_g(g15_12)
);

bit4_cla t2 (
    .ain(ain[11:8]),
    .bin(bin_actual[11:8]),
    .cin(c7),
    .sum(sum[11:8]),
    .cas_p(p11_8),
    .cas_g(g11_8)
);

bit4_cla t1 (
    .ain(ain[7:4]),
    .bin(bin_actual[7:4]),
    .cin(c3),
    .sum(sum[7:4]),
    .cas_p(p7_4),
    .cas_g(g7_4)
);

bit4_cla t0 (
    .ain(ain[3:0]),
    .bin(bin_actual[3:0]),
    .cin(cin_actual), // ??????cin
    .sum(sum[3:0]),
    .cas_p(p3_0),
    .cas_g(g3_0)
);

//*** ?????? ***
bit4cla_logic cla_logic (
    .cin(cin_actual), // ??????cin
    .p3(p15_12), .g3(g15_12),
    .p2(p11_8), .g2(g11_8),

```

```

        .p1(p7-4), .g1(g7-4),
        .p0(p3-0), .g0(g3-0),
        .c3(cout), .c2(c11), .c1(c7), .c0(c3)
    );
endmodule

```

(四) 实验 4: 移位式二进制乘法器实验

1. 乘法器设计

代码:

```

//*****
//** first generated on 28th,may,2017 **
//*****

module bit16_mult (arst,srst,clk,
                   opa,opb,op_ld,

                   mult_out);

input             arst,srst,clk;
input  [15:0]     opa,opb;
input             op_ld;

output  [31:0]    mult_out;
reg     [31:0]    mult_out;

//*****

//** generate calculate enable signal **
reg  cal_enb;
wire cal_end;

always @(posedge clk or negedge arst)
    if (~arst)
        cal_enb <= 1'b0;
    else if (srst || cal_end)
        cal_enb <= 1'b0;
    else if (op_ld)
        cal_enb <= 1'b1;

//** shift - add cycle control **
reg [3:0] cal_cnt;

always @(posedge clk or negedge arst)
    if (~arst)
        cal_cnt <= 4'h0;
    else if (srst || op_ld)
        cal_cnt <= 4'h0;
    else if (cal_enb)
        cal_cnt <= cal_cnt + 1'b1;

assign cal_end = &cal_cnt;

//** partial-product select **
wire [15:0] par_product;

```

```

reg    [15:0]  multiplicand;

assign par_product = (mult_out[0] == 1'b1) ? multiplicand : 16'h0000;

/** sum of partial-product */
wire   [16:0]  sum_pproduct;

assign  sum_pproduct = par_product + mult_out[31:16];

/** operands load-in & shift operation */

always @(posedge clk or negedge arst)
  if (~arst)
    begin
      multiplicand <= 16'h0000;
      mult_out <= 32'h00000000;
    end
  else if (srst)
    begin
      multiplicand <= 16'h0000;
      mult_out <= 32'h00000000;
    end
  else if (op_ld)
    begin
      multiplicand <= opa;
      mult_out <= {16'h0000, opb};
    end
  else if (cal_enb)
    mult_out <= ((sum_pproduct, mult_out[15:0])) >> 1;

endmodule

//=====
/** 4-bit counter */
//=====

module bin_cnt_4bit (
  input  async_rst,
  input  sync_rst,
  input  clk,
  input  enb,
  input  [3:0] d_in,
  input  d,

  output [3:0] cnt_out,
  output cout
);

reg [3:0] cnt;

always @(posedge clk or posedge async_rst)
  if (async_rst)
    cnt <= 4'b0000;
  else if (sync_rst)
    cnt <= 4'b0000;

```

```
else if (d)
    cnt <= d_in;
else if (enb)
    cnt <= cnt + 4'b0001;

assign cnt_out = cnt;
assign cout = (cnt == 4'b1111) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule
```

六、实验总结与体会

本次集成电路设计系列实验按实验 1 至实验 4 的顺序，系统覆盖了 MOS 管特性、状态机、运算电路及乘法器设计，通过理论学习与实践操作相结合，全面提升了集成电路设计能力。

实验 1 中，通过 MOS 管特性测试理解了器件参数对导电性能的影响，通过 CMOS 反相器延迟测试掌握了电路时序优化方法，深刻认识到模拟电路参数与数字电路性能的关联。实验 2 的状态机设计让我熟练运用 Verilog HDL 实现时序逻辑，通过修改计数器和解码器逻辑，体会到数字电路设计的灵活性，学会了通过测试向量验证电路功能。实验 3 的 16-bit CLA 设计中，层次化设计方法显著提高了设计效率，超前进位逻辑的递归实现让我深入理解了进位优化的核心思想。实验 4 的移位式乘法器设计，通过“部分积生成-右移累加”的逻辑实现，理解了复杂运算电路的时序协调方法，完备性测试确保了电路在全输入范围内的可靠性。

在实验过程中，也遇到了诸多问题：如 LFSR 反馈逻辑设计错误导致序列周期不符合预期，通过查阅生成多项式原理修正了反馈节点；乘法器时序控制逻辑调试中，通过波形分析定位了移位与累加的时序冲突。这些问题的解决，培养了我的问题分析和调试能力。

本次实验不仅巩固了集成电路设计的基础知识，还提升了硬件描述语言编程、仿真软件操作及实验数据处理能力，深刻体会到理论与实践结合的重要性。未来，我将进一步学习复杂电路设计技巧，优化电路性能，为后续专业学习和工程实践打下坚实基础。